



■ 主要用途

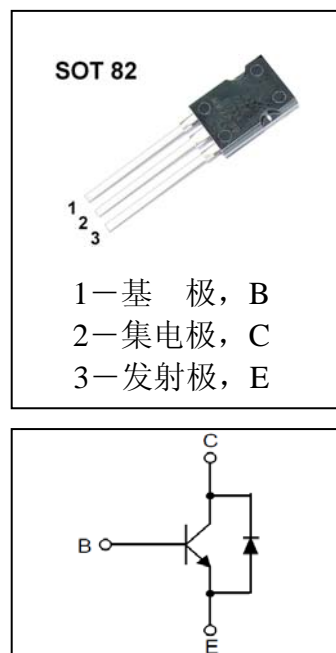
高压快速开关。电子镇流器、电子变压器等应用。

■ 极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

T_{stg} ——贮存温度	-55~150 $^\circ\text{C}$
T_j ——结温	150 $^\circ\text{C}$
P_C ——集电极功率耗散 ($T_c=25^\circ\text{C}$)	40W
V_{CBO} ——集电极—基极电压	700V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压	400V
V_{EBO} ——发射极—基极电压	9V
I_C ——集电极电流 (DC)	4A
I_C ——集电极电流 (脉冲)	8A
I_B ——基极电流	2A

■ 电参数 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

■ 外形图及引脚排列



参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	700			V	$I_C=1\text{mA}, I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	400			V	$I_C=5\text{mA}, I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	9			V	$I_E=1\text{mA}, I_C=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			1	mA	$V_{EB}=9\text{V}, I_C=0$
h_{FE}	直流电流增益	10		40		$V_{CE}=5\text{V}, I_C=1\text{A}$
		8		40		$V_{CE}=5\text{V}, I_C=2\text{A}$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压			0.5	V	$I_C=1\text{A}, I_B=0.2\text{A}$
				0.8	V	$I_C=2\text{A}, I_B=0.5\text{A}$
				1	V	$I_C=4\text{A}, I_B=1\text{A}$
$V_{BE(sat)}$	基极—发射极饱和电压			1.2	V	$I_C=1\text{A}, I_B=0.2\text{A}$
				1.6	V	$I_C=2\text{A}, I_B=0.5\text{A}$
V_F	内部二极管正向压降			2.5	V	$I_F=2\text{A}$
C_{ob}	共基极输出电容		65		pF	$V_{CB}=10\text{V}, f=0.1\text{MHz}$
f_T	特征频率	4			MHz	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=0.5\text{A}$
t_{on}	导通时间			0.8	μs	} $V_{CC}=125\text{V}, I_C=2\text{A},$ $I_{B1}=-I_{B2}=0.4\text{A}$
t_s	载流子贮存时间			4	μs	
t_f	下降时间			0.9	μs	

分档: H1(10--16) H2(14--21) H3(19--26) H4(24--31) H5(29--40)



■ 特性曲线

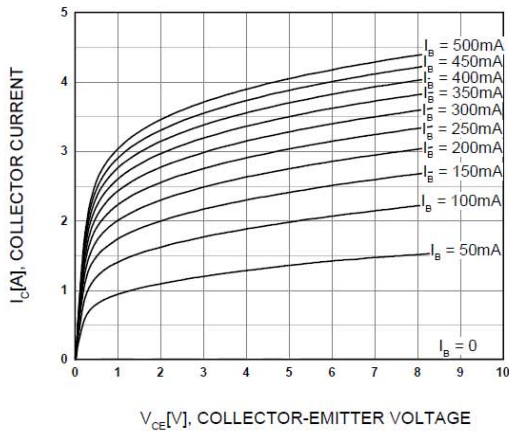


Figure 1. Static Characteristic

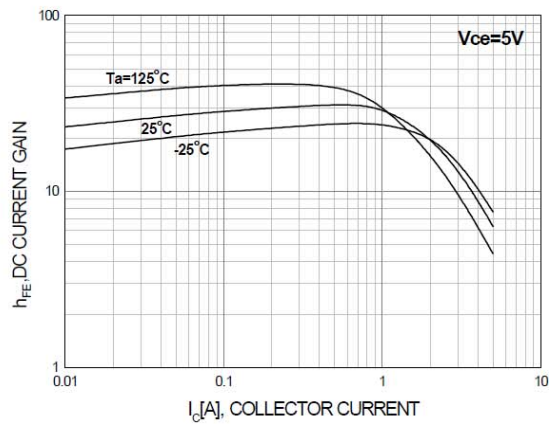


Figure 2. DC Current Gain

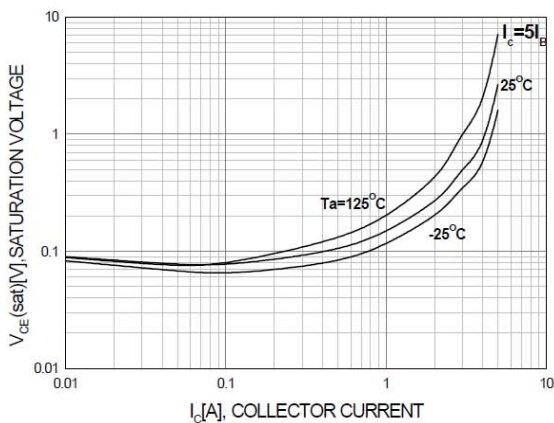


Figure 3. Collector-Emitter Saturation Voltage

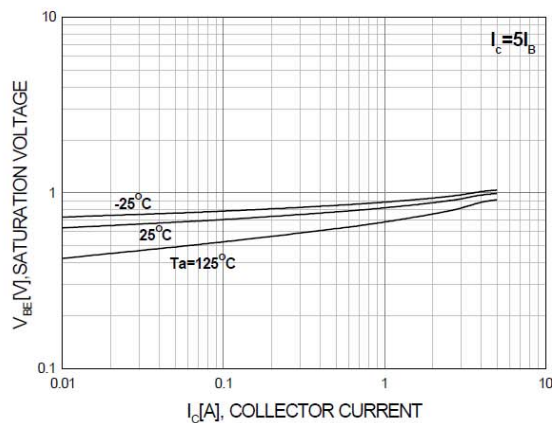


Figure 4. Base-Emitter Saturation Voltage

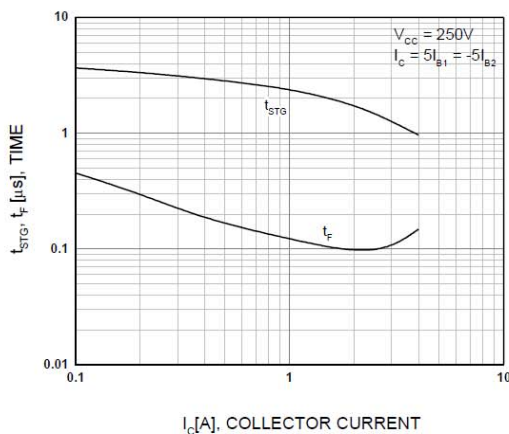


Figure 5. Resistive Load Switching Time

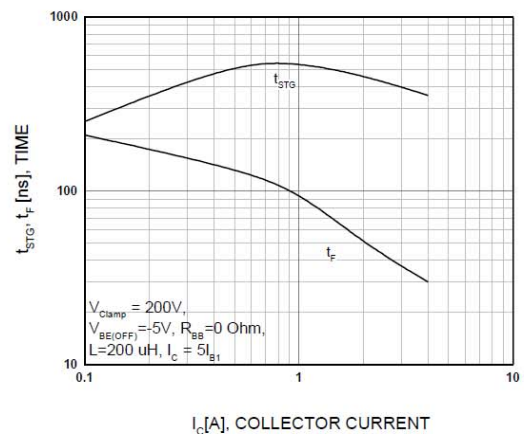


Figure 6. Inductive Load Switching Time



■ 特性曲线

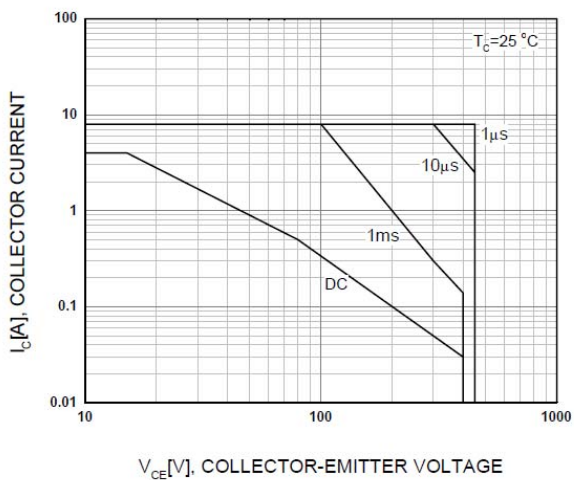


Figure 7. Forward Bias Safe Operating Area

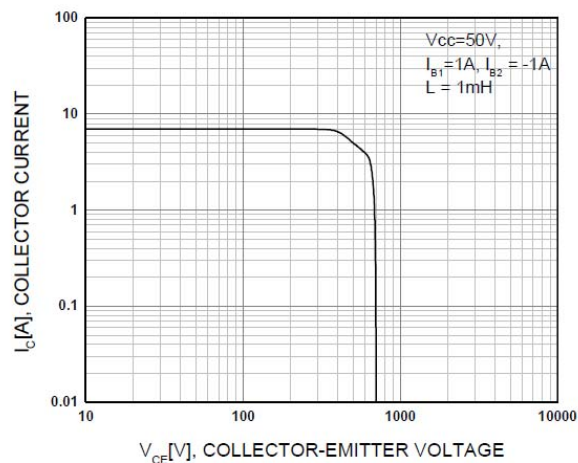


Figure 8. Reverse Bias Safe Operating Area

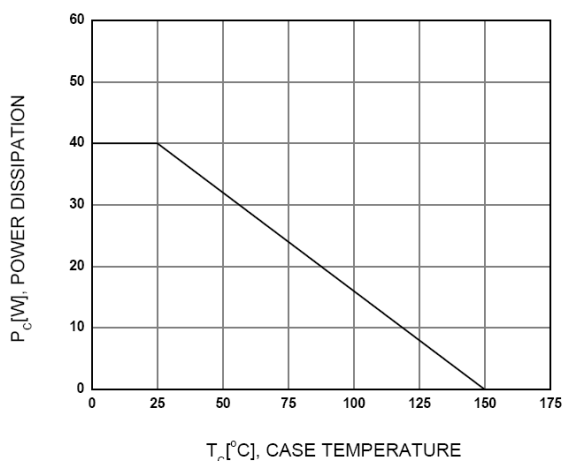


Figure 9. Power Derating